
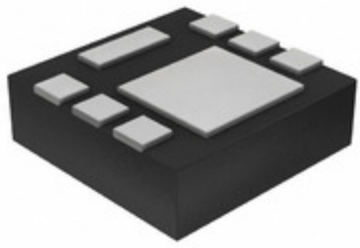
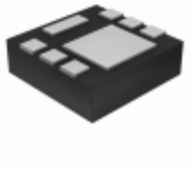
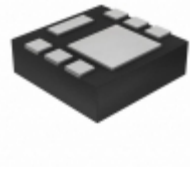





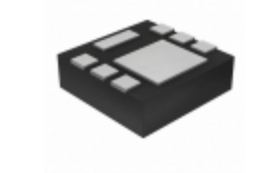
	<h2 style="color: #E67E22;">RF4E075ATTCR</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: RF4E075ATTCR</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 7.5A 8DFN</p> <hr/> <p>Datenblätter:  RF4E075ATTCR.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 64036 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	RF4E075ATTCR
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 7.5A 8DFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	64036 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	150 °C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerUDFN
Supplier Device-Gehäuse	6-HUML2020L8 (2x2)
Verlustleistung (max)	2W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.5A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	21.7 mOhm @ 7.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1000pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

RF4E075ATTCR ist neu im Original, Suche RF4E075ATTCR Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie RF4E075ATTCR LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage RF4E075ATTCR: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>RF4E080GNTR LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 30V 8A 8-HUML</p>	 <p>RF4E070GNTR LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 30V 7A 8-HUML</p>	 <p>RF4E080BN TB ROHM RF4E080BN TB ROHM</p>	 <p>RF4E080BN ROHM RF4E080BN ROHM</p>
 <p>RF4E070BNTR LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 30V 7A 8-HUML</p>	 <p>RF4E100AJTCR LAPIS Semiconductor NCH 30V 10A MIDDLE POWER MOSFET</p>	 <p>RF4E075AT TCR ROHM RF4E075AT TCR ROHM</p>	 <p>RF4E080BNTR LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 30V 8A 8-HUML</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ 06031A131GAT2A	↔ 08051A880FAT2A	⇒ 5SGR20L4501	D A-PR02-DRV075	⇒ AD7875KR
⊖ ADP3333ARMZ-2.5-R7	⊕ BC41B143A06	D BD5239FVE-TR	⇒ BZD27C150P-E3-08	⇒ CL31B331KBCNNNC
⊕ EV1320QI	⊖ FC1610-TC-AF	⊕ FM-1040FN-F-SNR	↔ GCM2165C1H120GZ13J	⇒ IS42S16100C1-6TL
D LA1845NV-TLM-E	⊕ MAXQ3180-RAN	⊖ NCP1581DR2G	⊕ PACUSB-U3Y6R	⇒ RF4013GFE8
⇒ RF4013TRN7	↔ RF4016-000	⊕ RF4018-000	⊖ RF4021-000	⇒ RF4165-000
↔ RF4180ATR13	⇒ RF4180DTR13	D RF4180TR13	⊕ RF430CL330HCPWR	⊖ RF430F5144BIRKVRQ1
⊕ RF430F5144CIRKVRQ1	D RF430F5144Q1	⇒ RF430F5144S1	↔ RF430F5144SQ1-1	⇒ RF430F5155AQ1-1
⊖ RF430F5175AQ1-1	⊕ RF430F5175T1	↔ RF430V5140AQ1	⇒ RF4C050AP	⇒ RF4E080BN
⊕ RF4E080BNTR	⊖ RF4E080GNTR	⊕ RF4E110BN	D SST25VF080B-80-4I-S2AE	⇒ TD200F10KSC
↔ TEM2-2421	⊕ TMK105BJ103KP-F	⊖ UND-300B/125	⊕ UPD78P064BGC	⇒ VI-20M-IY

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited